酸素スプレー法を用いた反応性スパッタリングによる **Ba**(**Zr**_{I-x}**Ti**_x)**O**₃ 膜の作製 Fabrication of Ba(**Zr**_{I-x}**Ti**_x)**O**₃ film by reactive sputtering method using oxygen spray 防衛大 牧野 碧, 篠原 崇之, 砂岡 裕基, 西田 謙

National Defense Academy, Ao Makino, Takayuki Shinohara, Yuki Sunaoka and Ken Nishida

E-mail:em57004@nda.ac.jp

1 はじめに

近年、チタン酸バリウム $BaTiO_3$ (BT) の Ti サイトを Zr 置換した $Ba(Zr_{1-x}Ti_x)O_3$ (BZT)のセラミックスが高誘電率、低誘電損失及びチューナブル特性を有するる。 我々は基板上で誘電材料として注目されてさる。 我々は基板上で優れ、緻密で推力の高い膜作業をとで、結晶性に優れ、緻密で流着性のて製膜作業をとる反応性スパッタリング法間を用いて製膜に最大ので、金属ターゲットを用いるとの際、金属ターゲットを用いるとりの酸化の抑制及び基板上の酸化速度の向上をが立る、酸素スプレー法を用いている。これにより、の酸素スプレー法を用いている。これに力つ、製造で作成したものと同様の結晶性を維持しつつ、製度速度が改善されたことを BT の製膜において確認した。

今回は酸素スプレー法を用いた製膜法において、BZT 膜の製膜速度の向上は可能か検証すると同時に、作製 した BZT 膜の評価を行った。

2 実験方法

2.1 製膜装置

本研究では、RF マグネトロンスパッタ法を用いる。また、ターゲットの酸化の抑制及び基板の酸化速度の向上を両立するために、酸素側のノズルをホルダー付近まで延長する酸素スプレー法を用いた。スパッタリング装置内部の改良前後の比較図を図1に示す。

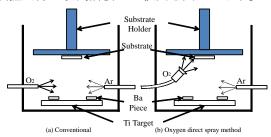


Fig.1 Schematic drawing of sputtering equipment

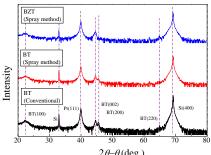
2.2 強誘電体 BZT 膜の作製・評価

本研究では、前述したスパッタリング装置を用いて Pt/Si 基板上に BZT 膜を作製した。スパッタのターゲットには反応性が高く、低温成長が望める Ba 金属小片及び Zr 金属小片を Ti 金属円板上に配置したものを用いた。 BZT 膜の製膜に使用する基板は、Pt/Si 基板を用いた。 製膜条件については、製膜時間 $1\sim5$ 時間、基板温度 600 $^{\circ}$ $^{$

3 実験結果及び考察

従来手法で作製した BT と酸素スプレー法で作成した BT 及び BZT の XRD パターンを図 2 に、ラマンスペクトルを比較したもの図 3 に、ヒステリシス特性の比

較図を図4に示す。XRDより(002)及び(200)のピークが分離していることから正方晶であることが分かる。ラマンスペクトルからも同様に正方晶のスペクトルが観察できた。しかしながらヒステリシス特性においては、ループが小さくなっており、常誘電性が強くなっていた。これらは Zr 置換の影響によるものと考えられる。SEM で断面観察した結果、化合物モードでの BZT 膜は、70 nm/hの製膜速度であったが、酸素スプレー法を用いることにより1時間で180nm/hと約2倍以上の速度で製膜できていることが分かった。このことから酸素スプレー法を用いることで従来作成に長時間を要していたBZT 膜の製膜速度を高速化することができた。



 2θ - θ (deg.) Fig.2 XRD pattern of of BT and BZT film

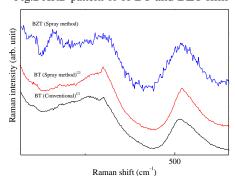


Fig.3 Raman spectra of of BT and BZT film

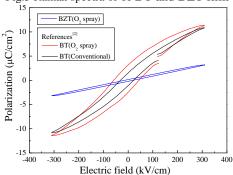


Fig.4 P-E hysteresis characteristics of BT and BZT film

参考文献

[1] J.Musil *et.al*. Thin Solid Films **475**(2005) pp. 208-218 [2]牧野 他:第 66 回春季応物予稿集, 10a-3PA-5(2019)